

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application: 2 0 0 4 年 7 月 1 4 日

出 願 番 号  
Application Number: 特 願 2 0 0 4 - 2 0 7 8 9 6

パリ条約による外国への出願  
に用いる優先権の主張の基礎  
となる出願の国コードと出願  
番号

The country code and number  
of your priority application,  
to be used for filing abroad  
under the Paris Convention, is

J P 2 0 0 4 - 2 0 7 8 9 6

出 願 人  
Applicant(s): 株式会社村田製作所

2 0 0 5 年 7 月 1 3 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

小 川



【特許番号】	特許第
【整理番号】	34-0384
【あて先】	特許庁長官殿
【国際特許分類】	H03H 9/25
【発明者】	
【住所又は居所】	京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田製作所内
【氏名】	岩本 敬
【発明者】	
【住所又は居所】	京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田製作所内
【氏名】	越戸 義弘
【特許出願人】	
【識別番号】	000006231
【氏名又は名称】	株式会社村田製作所
【代理人】	
【識別番号】	100114502
【弁理士】	
【氏名又は名称】	山本 俊則
【電話番号】	06-6367-8111
【手数料の表示】	
【予納台帳番号】	209898
【納付金額】	16,000円
【提出物件の目録】	
【物件名】	特許請求の範囲 1
【物件名】	明細書 1
【物件名】	図面 1
【物件名】	要約書 1
【包括委任状番号】	0403106

【請求項 1】

圧電基板と、

前記圧電基板の主面に形成された、IDTを含む導電パターンと、

前記圧電基板の前記主面において前記IDTの周囲に配置された支持層と、

前記支持層に配置された後、前記圧電基板の前記主面の法線方向から見たとき前記圧電基板の外周より内側が除去されて、前記圧電基板の前記外周より内側に前記圧電基板の前記外周と全周に渡って間隔を設けて延在するカバーと、

前記カバーから前記圧電基板の前記主面の周部まで全体的に覆う補強樹脂とを備えたことを特徴とする、弾性表面波装置。

【請求項 2】

前記カバーは、前記支持層の周面よりも外側まで延在することを特徴とする、請求項 1 に記載の弾性表面波装置。

【請求項 3】

前記カバー又は前記支持層が、ポリイミド樹脂、ベンゾシクロブテン樹脂又はシリコン樹脂であり、

前記補強樹脂が、エポキシ樹脂であることを特徴とする、請求項 1 又は 2 に記載の弾性表面波装置。

【請求項 4】

複数の弾性表面波装置を同時に製造する、弾性表面波装置の製造方法であって、

主面にIDTを含む導電パターンが形成され、前記IDTの周囲に支持層が形成された圧電基板について、前記支持層の上にカバーを配置する工程と、

前記圧電基板の法線方向から見たとき、一つの弾性表面波装置となる前記圧電基板の外周より内側に前記圧電基板の前記外周と全周に渡って間隔を設けて延在するように、前記カバー側から前記圧電基板まで、少なくとも前記カバーの前記圧電基板の前記外周より内側をレーザー光で除去する工程と、

前記圧電基板より前記カバー側を、前記カバー側から前記圧電基板まで全体的に覆うように、前記圧電基板及び前記カバーに補強樹脂を配置する工程とを含むことを特徴とする、弾性表面波装置の製造方法。

【請求項 5】

前記レーザー光は、波長が355nm以下であることを特徴とする、請求項 4 に記載の弾性表面波装置の製造方法。

【請求項 6】

前記カバーを除去する工程と、前記補強樹脂を配置する工程との間に、

一つの弾性表面波装置となる境界線に沿って前記圧電基板の前記主面に形成された前記導電パターンを除去する工程を備えたことを特徴とする、請求項 4 又は 5 に記載の弾性表面波装置の製造方法。

【請求項 7】

前記圧電基板及び前記カバーに補強樹脂を配置する工程において、減圧雰囲気中で前記補強樹脂を硬化させることを特徴とする、請求項 4、5 又は 6 に記載の弾性表面波装置の製造方法。

本発明は、共振子やフィルタなどの弾性表面波を利用した弾性表面波装置に関する。

近年、弾性表面波フィルタ（SAWフィルタ）などの弾性表面波装置について、素子チップサイズまでパッケージを小型化するチップサイズパッケージ（CSP）の開発が進められている。

例えば図5に示す弾性表面波装置2は、IDT（Inter Digital Transducer；櫛型電極）4aやパッド4bなどの導電パターンが形成された圧電基板3の一方の主面3aに、支持層5を介してカバー6を設け、カバー6から外部電極7が露出するようになっていて、回路基板1の配線パターン1aに対して所定位置に、フェイスダウン実装する（例えば、特許文献1参照）。

【特許文献1】特開平11-251866号公報（図1）

特許文献1に開示された弾性表面波装置2は、カバー6に穴を加工し、この穴に外部電極7を電解めっきや蒸着で埋めることにより、外部電極7をパッド4bと電気的に接続する。そのため、IDT4aの周囲の振動空間を十分に密封できないため、回路基板1に弾性表面波装置2を実装した後に、パッファ樹脂8を介して補強樹脂9で覆うことにより、封止する必要がある。

本発明は、かかる実情に鑑み、小型化しつつ耐湿性を向上することができ、回路基板に実装した後に封止する必要がある弾性表面波装置及びその弾性表面波装置の製造方法を提供することを目的とする。

本発明は、上記課題を解決するため、以下のように構成した弾性表面波装置を提供する。

弾性表面波装置は、圧電基板と、前記圧電基板の主面に形成された、IDTを含む導電パターンと、前記圧電基板の前記主面において前記IDTの周囲に配置された支持層と、前記支持層に配置された後、前記圧電基板の前記主面の法線方向から見たとき前記圧電基板の外周より内側が除去されて、前記圧電基板の前記外周より内側に前記圧電基板の前記外周と全周に渡って間隔を設けて延在するカバーと、前記カバーから前記圧電基板の前記主面の周部まで全体的に覆う補強樹脂とを備える。

上記構成において、IDTは、支持層により間隔を設けてカバーと対向し、IDT内で弾性表面波が自由に伝搬する。補強樹脂によりIDTを密封することができるので、十分な耐湿性が得られ、回路基板に実装した後に樹脂で覆う必要がない。

好ましくは、前記カバーは、前記支持層の周面よりも外側まで延在する。

上記構成によれば、支持層よりも大きいカバー材を支持層の上に配置し、支持層の外側を除去することにより、支持層を除去することなくカバー材のみを除去し、除去したカバー材によってカバーを形成することができる。これにより、除去作業量をできるだけ少な

、行うことができる、加工速度を早くできる。また、カバーと補強樹脂の接界面積を大きくでき、封止性を向上できる。

#### 【0011】

好ましくは、前記カバー又は前記支持層が、ポリイミド樹脂、ベンゾシクロブテン樹脂又はシリコン樹脂である。前記補強樹脂が、エポキシ樹脂である。

#### 【0012】

樹脂が硬化する際にハロゲンガスが発生すると、IDT、圧電基板の腐食や、弾性表面波素子表面への付着によって特性劣化の原因となる。上記構成によれば、ハロゲンガスが発生しない樹脂を用いるので、このような問題を防止することができる。

#### 【0013】

また、本発明は、上記課題を解決するため、以下のように構成した弾性表面波装置の製造方法を提供する。

#### 【0014】

弾性表面波装置の製造方法は、複数の弾性表面波装置を同時に製造する。弾性表面波装置の製造方法は、主面にIDTを含む導電パターンが形成され、前記IDTの周囲に支持層が形成された圧電基板について、前記支持層の上にカバーを配置する工程と、圧電基板の法線方向から見たとき、一つの弾性表面波装置となる前記圧電基板の外周より内側に前記圧電基板の前記外周と全周に渡って間隔を設けて延在するように、前記カバー側から前記圧電基板まで、少なくとも前記カバーの前記圧電基板の前記外周より内側をレーザー光で除去する工程と、前記圧電基板より前記カバー側を、前記カバー側から前記圧電基板まで全体的に覆うように、前記圧電基板及び前記カバーに補強樹脂を配置する工程とを含む。

#### 【0015】

IDTは、支持層により間隔を設けてカバーと対向し、IDT内で弾性表面波が自由に伝搬する。IDTは、補強樹脂により密封されるので、十分な耐湿性が得られ、回路基板に実装した後に樹脂で覆う必要がない。

#### 【0016】

カバーをレーザーで除去するとき、一つの弾性表面波装置となる境界線に沿って支持層がなければカバーのみを、あれば支持層も除去する。

#### 【0017】

補強樹脂側に外部電極を設ける場合、圧電基板の導電パターンと外部電極とを電氣的に接続する配線を通すため、カバーに貫通孔を形成する。この貫通孔を形成するために用いるレーザーで、カバーの除去も行うことができる。

#### 【0018】

好ましくは、前記レーザー光は、波長が355nm以下である。

#### 【0019】

上記波長のレーザー光は、樹脂を除去するが、金属は除去しない。そのため、圧電基板上に、一つの弾性表面波装置となる境界線に沿って金属の給電ラインなどを形成した場合に、カバーを除去し、金属の給電ラインなどを残しておき、カバーの除去後に、電解めっきの際の給電や、圧電基板の焦電のアースなどに利用することができる。

#### 【0020】

好ましくは、前記カバーを除去する工程と、前記補強樹脂を配置する工程との間に、一つの弾性表面波装置となる境界線に沿って前記圧電基板の前記主面に形成された前記導電パターンを除去する工程を備える。

#### 【0021】

この場合、圧電基板と補強樹脂との間に導電パターンがないので、耐湿性を向上することができる。

#### 【0022】

弾性表面波装置の境界線に沿って形成された導電パターンは、電解めっきの給電ラインとして利用できるが、除去した後は利用できないため、外部電極を電解めっきにより形成することは困難になる。この場合には、無電解めっきにより形成する。又は、補強樹脂を

配線する前に、ＩＤＴに電気的に接続された金属柱をカバー上に形成しておく。この金属柱が、補強樹脂を配置した後に補強樹脂から露出するようにすればよい。

#### 【００２３】

好ましくは、前記圧電基板及び前記カバーに補強樹脂を配置する工程において、減圧雰囲気中で前記補強樹脂を硬化させる。

#### 【００２４】

補強樹脂が硬化する際に発生する硬化ガス中に、ハロゲンガスのように特性劣化の原因となる悪影響成分が含まれていても、ＩＤＴを密封した空間内に入ることを防止することができる。したがって、硬化ガス中の悪影響成分による特性劣化を防ぐことができる。

#### 【発明の効果】

#### 【００２５】

本発明の弾性表面波装置は、小型化しつつ耐湿性を向上することができ、回路基板に実装した後に封止する必要がない。また、本発明の弾性表面波装置の製造方法によれば、小型化しつつ耐湿性を向上することができ、回路基板に実装した後に封止する必要がない弾性表面波装置を製造することができる。

#### 【発明を実施するための最良の形態】

#### 【００２６】

以下、本発明の実施の形態について実施例を、図１～図４を参照しながら説明する。

#### 【００２７】

図１の断面図に示すように、表面波フィルタ１０は、圧電基板１２の一方の主面である上面１４に、ＩＤＴ２２とパッド２４を含む導電パターン２０が形成されている。上面１４には、支持層３０によって間隔を設けてカバー５０を配置して、ＩＤＴ２２の周囲に振動空間２６を形成する。支持層３０はＩＤＴ２４の周囲に形成され、圧電基板１２の振動空間２６に隣接する部分において、弾性表面波が自由に伝搬するようになっている。さらに、補強樹脂７０により、カバー５０から上面１４の周部まで全体的に覆っている。補強樹脂７０からは外部電極８０が露出しており、表面波フィルタ１０を電気機器等の回路基板に実装することができるようになっている。圧電基板１２の他方の主面１５（図において下面）には、保護樹脂１６が配置されている。

#### 【００２８】

カバー５０は、支持層３０を覆い、支持層３０の周面３４まで延在している。カバー５０は、周面３４よりも外側まで延在してもよい。詳しくは後述するが、カバー５０及び補強樹脂７０には貫通孔が形成され、パッド２４と外部電極８０とを接続する電気配線が通るようになっている。

#### 【００２９】

補強樹脂７０は、表面波フィルタ１０の圧電基板１２の上面１４の外縁に沿って全周に渡って延在し、圧電基板１２の上面１４側を封止する。これによって、振動空間２６が密封され、外界から遮断される。

#### 【００３０】

表面波フィルタ１０は、複数個を同時に製造することができ、図２では、２つ表面波フィルタ１０を製造時の境界線とともに図示している。

#### 【００３１】

図２の平面図に示すように、外部電極８０として４つの外部電極８０ａ，８０ｂ，８０ｃ，８０ｄが設けられている。外部電極８０ａ，８０ｄはアース端子、外部電極８０ｂは入力端子、外部電極８０ｃは出力端子である。

#### 【００３２】

圧電基板１２のウェハの上面には、図２において一点鎖線で示した導電パターンが形成されている。なお、図２において右側の表面波フィルタ１０については、導電パターンの図示を省略している。

#### 【００３３】

すなわち、表面波フィルタ１０内には、ＩＤＴ２２として４つのＩＤＴ２２ａ，２２ｂ

、22c、22dが形成され、パッド24として以下のパッド24a、24b、24c、24d、24xが形成されている。また、IDT22a、22b、22c、22dの各電極端子とパッド24a、24b、24c、24d、24xとを接続する配線が形成されている。一方、隣接する表面波フィルタ10間の境界に、導電ライン21が形成されている。さらに、導電ライン21と表面波フィルタ10内の配線と接続するショートライン25a、25b、25c、25dが形成されている。IDT22aの両側とIDT22bのIDT22cに対する反対側とIDT22dのIDT22cに対する反対側とに反射器があってもよい。IDT又は反射器以外の導電パターンは必ずしも支持層30に含まれていなくてもよい。例えばパッド24a、24b、24c、24dとIDTを接続する配線の一部が支持層30の外に出てもよい。

#### 【0034】

支持層30の上に配置されたカバー50には、パッド24a、24b、24c、24d、24xに対応する位置に、後述する貫通孔（ビアホール）が形成されている。カバー50の上面には、図2において右側の表面波フィルタ10について2点鎖線で示したアース配線60が形成されている。なお、図2において左側の表面波フィルタ10については、アース配線60の図示を省略している。アース配線60の両端60a、60bは、カバー50と支持層30を貫通するビアホールを介して、パッド24a、24dと電気的に接続される。アース配線60の中間点60xは、カバー50と支持層30を貫通するビアホールを介して、IDT24xに接続されたパッド24xと、電気的に接続される。アース配線60は、IDT22aとIDT22b及び22dとを接続するホット配線と、絶縁体である支持層30及びカバー50を挟んで立体交差している。

#### 【0035】

図2において右側の表面波フィルタ10について点線で示すように、補強樹脂70には、矩形の孔72a、72b、72c、72dが形成され、この孔72a、72b、72c、72dを介して、外部電極80a、80b、80c、80dとパッド24a、24b、24c、24dとが電気的に接続される。なお、図2において左側の表面波フィルタ10については、補強樹脂70の矩形の孔の図示を省略している。

#### 【0036】

次に、表面波フィルタ10の製造方法について、図3を参照しながら説明する。

#### 【0037】

図3（a）に示すように、圧電基板12のウェハの上面14に、導電パターン20を形成する。例えば、厚さ0.3mm、直径100mmのLiTaO<sub>3</sub>基板上に、IDT22、パッド24、導電ライン21（図2参照）などの部分に、厚さ100nmのAl膜を蒸着リフトオフで形成する。導電ライン21の線幅は、20μmである。さらに、後のめっき時に給電膜とするために、パッド24と導電ライン21（図2参照）の部分について、厚さ10nmのTi及び厚さ1μmのAlをリフトオフ法で成膜する。

#### 【0038】

次に、図3（b）に示すように、圧電基板12のウェハの上面14に、支持層30を形成する。支持層30は、IDT22やパッド24の部分に開口を形成する。また、隣り合う表面波フィルタ10との間に間隔を設け、導電ライン21（図2参照）上にも開口を形成する。例えば、圧電基板12のウェハの上面14に、ネガ型の感光性ポリイミドを20μmの厚さで塗布し、乾燥・露光・PEB・現像を行い、IDT22、パッド24、及び隣り合う表面波フィルタ10との間の部分が開口したパターンの支持層30を形成する。このとき、グレートーンフォトマスクを用いることで、パッド24の開口部に、順テーパの傾斜面32を形成し、次の工程で配線40を形成しやすくする。

#### 【0039】

次に、図3（c）に示すように、パッド24から支持層30の上面のパッド部分（線幅30μm）まで延在する配線40を形成する。配線40は、後のめっき処理を考慮して、厚さ10nmのTi膜の上に厚さ3μmのCu膜を成膜する。このとき同時に、支持層30の上面のパッド部分と導電ライン21（図2参照）とを接続するショートライン25a

〜200nm（図2参照）を、支持層30の上面にも形成し、めっき層（銅厚50μm、膜厚は3μm）として用いる。なお、Cuの代わりにAlを採用すると、後のレーザー加工時のダメージが少ない点ではよいが、メッキ前処理としてシンジケート処理が必要であり、製造コストが増大する。

#### 【0040】

次に、図3（d）に示すように、カバー50を形成する。例えば、厚さ15μm〜35μmのポリイミドフィルムにポリイミド系接着剤を塗布したシートを、ロールラミネート法でウェハ全面に貼り付け、200℃で硬化させる。

#### 【0041】

次に、図3（e）に示すように、カバー50に貫通孔（ビアホール）52を形成するとともに、カバー50が支持層30の周面34よりも外側にはみ出した部分を除去し、隣り合う表面波フィルタ10の境界に溝54を加工する。例えば、THGレーザを用いてカバー50に、直径10μmのビアホール52と溝54を加工した後、O<sub>2</sub>アッシングでレーザ加工残渣を除去する。

#### 【0042】

THGレーザ（波長355nm）の場合、カバー50のポリイミドフィルムのレーザ光吸収率は99%、導電ライン21やショートライン25a〜25dのAlのレーザ光吸収率は10%程度であるので、カバー50のはみ出した部分をレーザで除去して溝54を形成するとき、その下の上面14に形成された導電ライン21等をレーザで除去することはない。SHGレーザ（波長532nm）、CO<sub>2</sub>レーザ（波長10.6μm）を用いる場合であっても、上面14に形成された導電ライン21等を厚く形成するなど、レーザ加工条件を適宜に選択すれば、1回の切断で、隣り合う表面波フィルタ10間に溝54を形成することができる。

#### 【0043】

隣り合う表面波フィルタ10の支持層30は、周面34により間隔が設けられているので、カバー50のみをレーザにより短時間で除去することができる。このとき、レーザビームの径が広がると、同じエネルギー密度（同等の加工速度、加工形状を得る）とするためには、大きな出力が必要であるため、加工幅はできるだけ小さくし、エネルギー密度を高くして加工速度を速くする、すなわち、除去後のカバー50が、支持層30の周面34よりも外側まで延在することが好ましい。また、カバーと補強樹脂の接触面積を大きくでき、封止性を向上できる。

#### 【0044】

次に、図3（f）に示すように、ビアホール52を導電材料で埋める。例えば、導電ライン21を給電膜として、Cu電解メッキでビアホール52を埋め込む。

#### 【0045】

次に、図3（g）に示すように、カバー50の上に、ビアホール52と外部電極80とを接続するためのアース配線60とホット配線65を形成する。例えば、リフトオフによりアース配線60とホット配線65を形成する。このとき、後のめっき性を考慮して、厚さ100nmのTi、厚さ1μmのAl、厚さ100nmのCuの順に形成する。

#### 【0046】

次に、図3（h）に示すように、補強樹脂70を圧電基板12のウェハの上面14側に塗布し、支持層30やカバー50などを補強樹脂70で覆った後、図3（i）に示すように、硬化した補強樹脂70に貫通孔72を形成し、アース配線60とホット配線65を露出させる。例えば、補強樹脂70として、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂又はアクリル酸エステル樹脂を塗布し、カバー50上の厚さが30μmとなるようし、直径100μmの貫通孔72を形成する。貫通孔72は、補強樹脂70に感光性樹脂を用いる場合にはリソグラフィで、非感光性樹脂を用いる場合にはレーザで形成する。

#### 【0047】

補強樹脂70が硬化する際にハロゲンガスが発生すると、IDT22、圧電基板12の腐食や、素子表面への付着によって特性劣化の原因となる。カバー50や支持層30にボ



エポキシ樹脂を用いると、ハロゲンガスが発生しないので好ましい。ハロゲンガスが発生する樹脂であっても、減圧雰囲気中で補強樹脂70を硬化させると、IDT22を密封した振動空間26内にハロゲンガスが入ることを防止することができ、特性劣化を防ぐことができる。

#### 【0048】

次に、図3(j)に示すように、貫通孔72を介してアース配線60とホット配線65に接続された外部電極80を形成するとともに、圧電基板12の裏面15に保護樹脂16を形成する。

#### 【0049】

具体的には、外部電極80の下地膜として、アース配線60とホット配線65の貫通孔72から露出した部分に、厚さ300nmのNi、厚さ100nmのAuを順に電解めっきで形成する。下地膜を形成する代わりに、Cu電解めっきで貫通孔72を埋めてNi、Auを電解めっきした外部電極80自体を形成してもよい。次に、圧電基板12のウェハの裏面にエポキシ樹脂を厚さ10μmで全面に塗布した後、貫通孔72の部分に外部電極用のハンダを印刷し、リフローすることにより、玉状の外部端子を形成する。

#### 【0050】

最後に、圧電基板12のウェハを、隣接する表面波フィルタ10間の境界でダイシングすることにより、表面波フィルタ10の個片に分割する。このとき、補強樹脂70を切断し、支持層30やカバー50がダイシングによって露出しないようにする。ただし、切断した表面波フィルタ10の側面には、ショートライン25a~25d(図2参照)の切断面が露出する。

#### 【0051】

上記のようにして表面波フィルタ10を製造する場合、アライメント接合プロセスがなく、カバー50は安価なロールラミネートであるので、製造コストを低減できる。THGレーザを用いることにより、カバー50に直径が10μmのピアホール52を形成でき、素子を小型化できる。感光性樹脂を用いないため、カバー50と補強樹脂70の材料選択自由度が大きくなる。カバー50や配線が補強樹脂70で覆われて露出しないので、信頼性を確保できる。めっきで配線を形成するため、ピア導通良品率が優れている。めっきとはんだを併用することにより、外部電極80の強度が高くなる。補強樹脂70や保護樹脂16により、実装衝撃などに対する強度を確保できる。支持層30、カバー50、補強樹脂70が樹脂であるので、その緩衝効果により、実装衝撃や熱衝撃で断線等の不具合が起りにくい。

#### 【0052】

次に、第2実施例の表面波フィルタ10aについて、図4を参照しながら説明する。

#### 【0053】

第2実施例では、第1実施例と製造工程の一部が異なるため、表面波フィルタ10aの側面からは、ショートライン25a~25d(図2参照)の切断面が露出しない。以下では、第1実施例との相違点を中心に説明する。

#### 【0054】

図4(a)~(d)に示すように、第1実施例と同様に、圧電基板12のウェハの上面14に、導電パターン20を形成した後、支持層30を形成する。そして、パッド24から支持層30の上面まで延在する配線40を形成した後、カバー50で覆う。

#### 【0055】

次に、図4(e)に示すように、カバー50に貫通孔(ピアホール)52を形成し、ピアホール52を導電材料で埋める。例えば、THGレーザを用いてカバー50に直径10μmのピアホール52を加工した後、O<sub>2</sub>アッシングでレーザ加工残渣を除去する。そして、導電ライン21(図2参照)を給電膜として、Cu電解メッキでピアホール52を埋め込む。

#### 【0056】

次に、図4(f)に示すように、カバーの上に、ピアホール52と外部電極80とを接



【図 1】表面波フィルタの断面図である。（実施例 1）

【図 2】表面波フィルタの平面図である。（実施例 1）

【図 3】表面波フィルタの製造工程の説明図である。（実施例 1）

【図 4】表面波フィルタの製造工程の説明図である。（実施例 2）

【図 5】表面波フィルタの断面図である。（従来例）

【符号の説明】

【0068】

10、10a 表面波フィルタ（弾性表面波装置）

12 圧電基板

14 上面（主面）

15 裏面

20 導電パターン

22 IDT

24 パッド

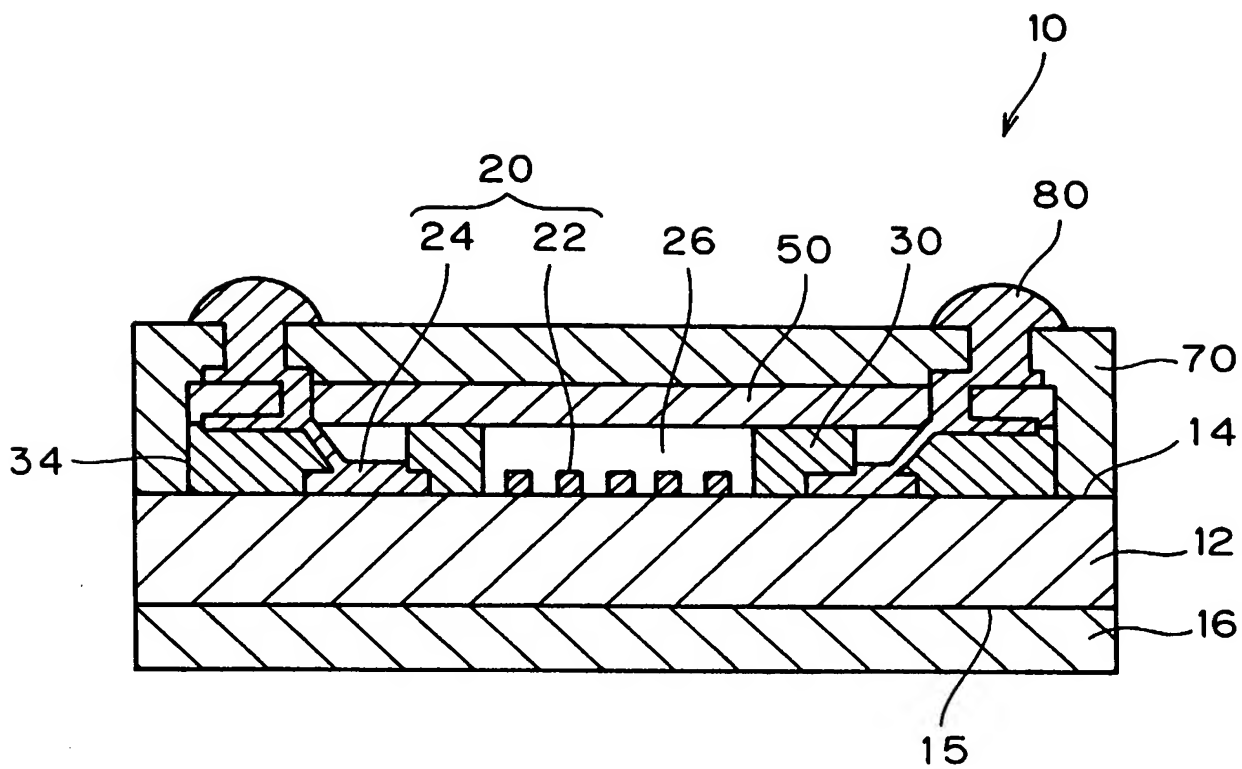
30 支持層

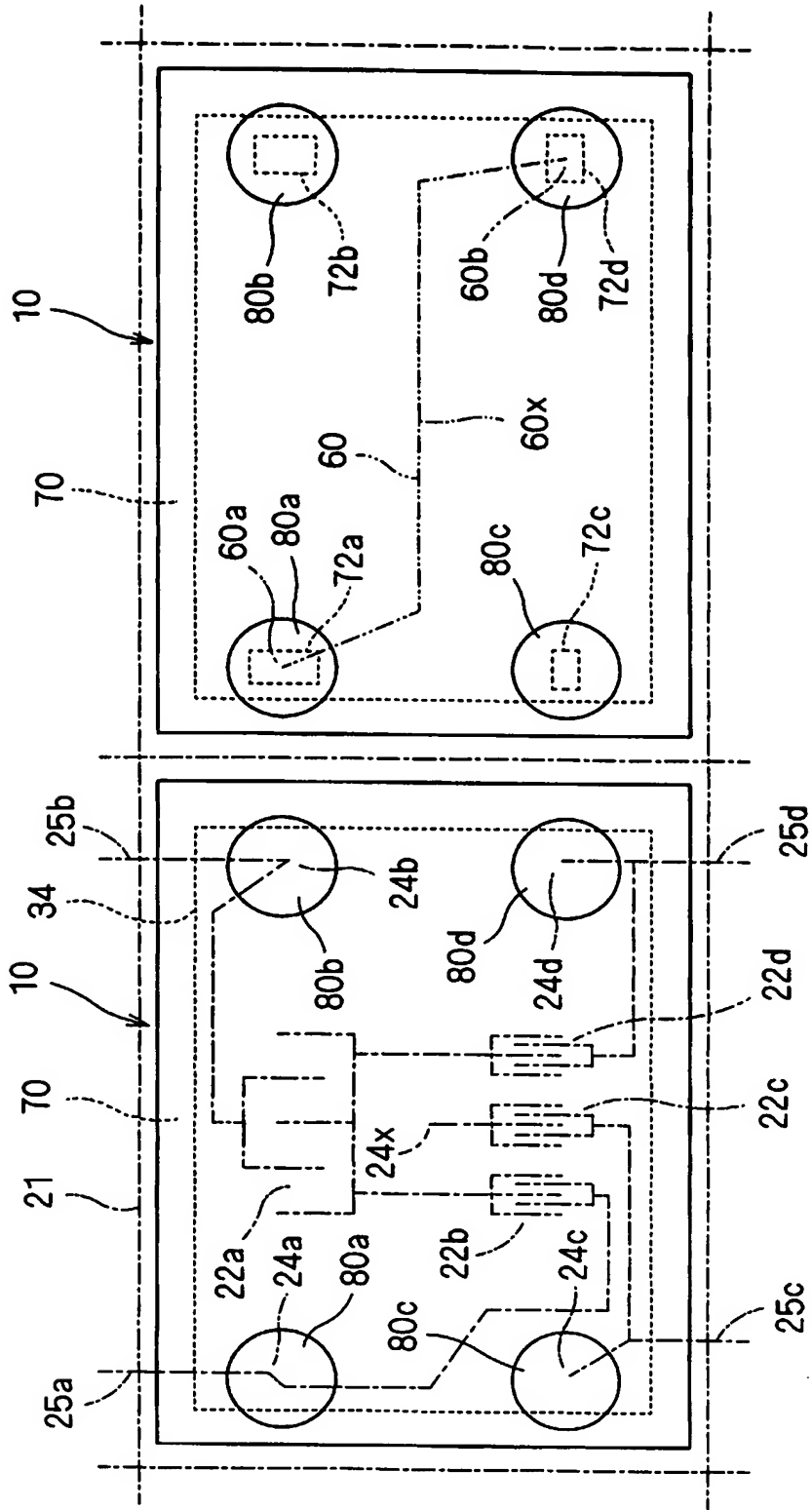
34 周面

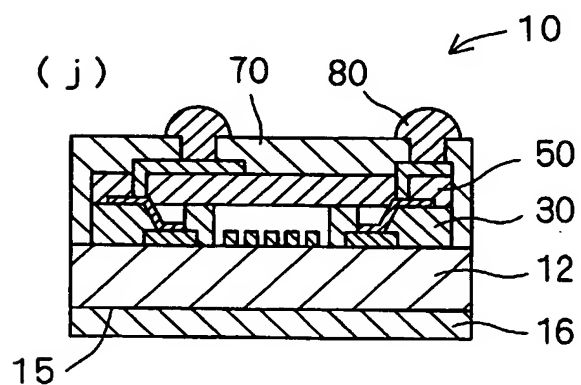
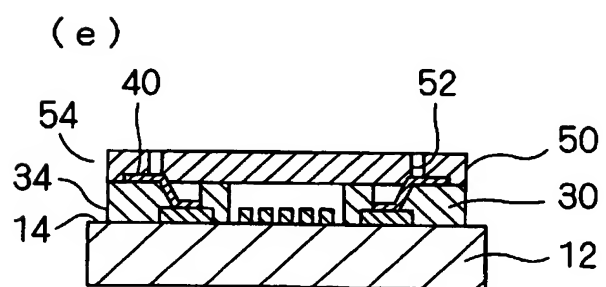
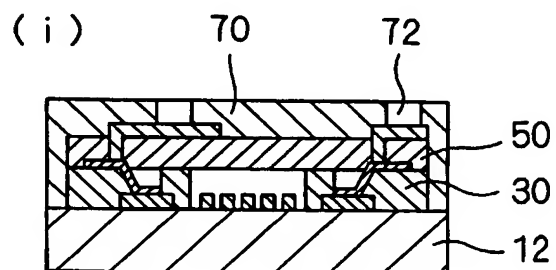
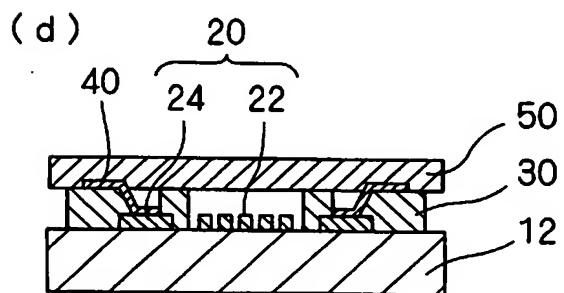
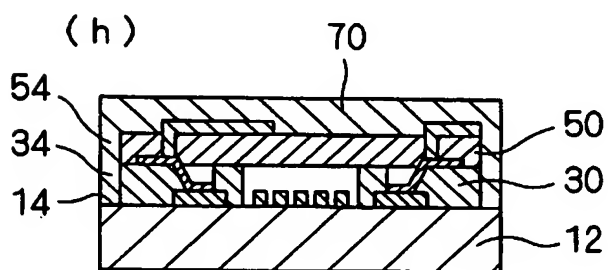
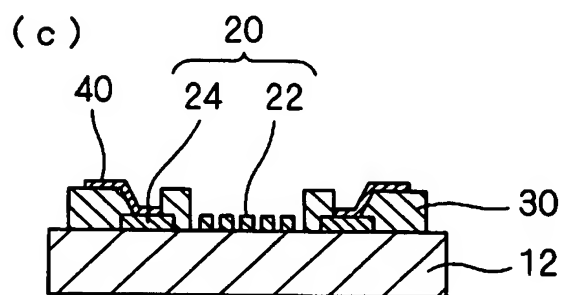
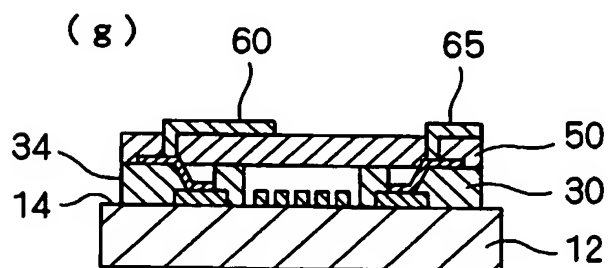
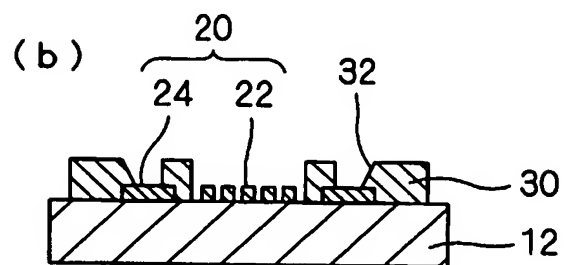
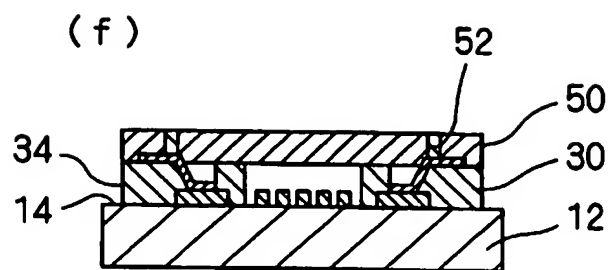
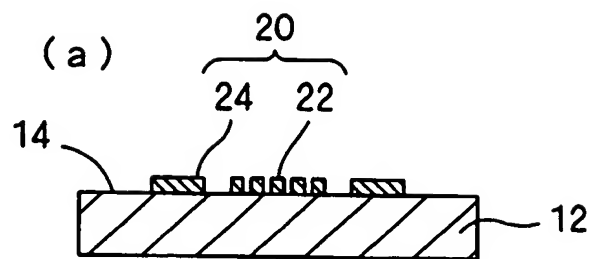
50 カバー

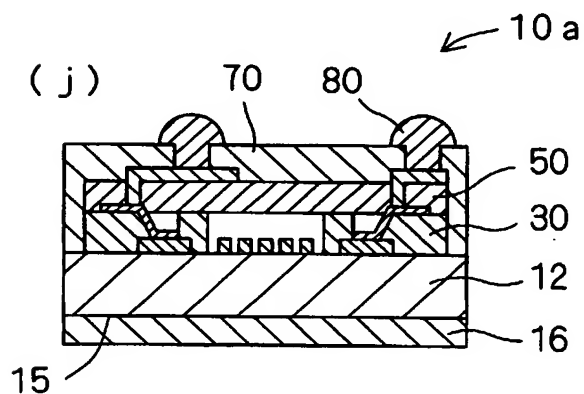
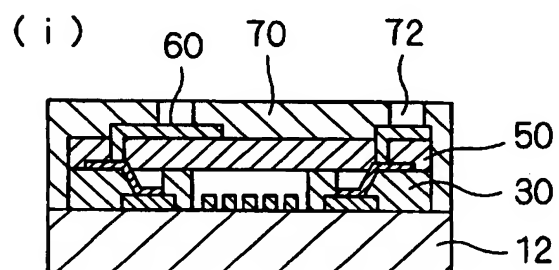
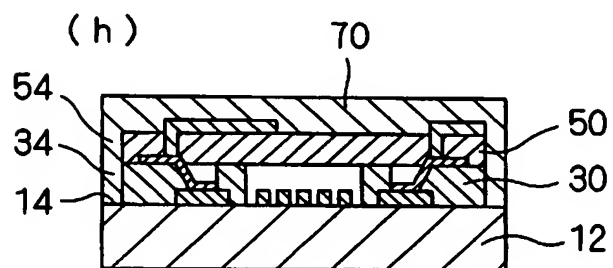
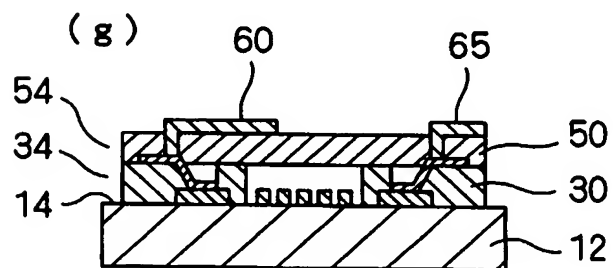
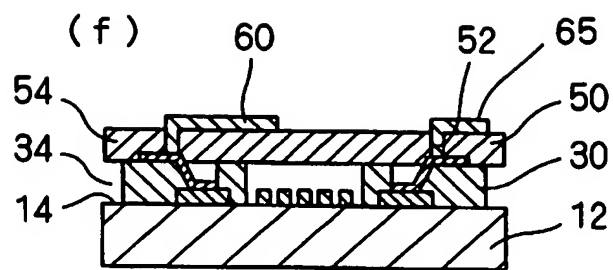
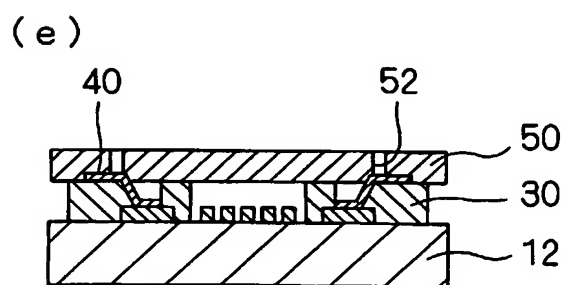
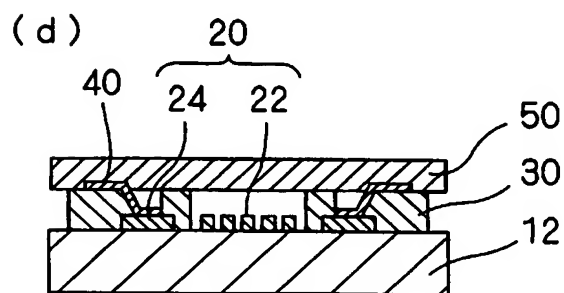
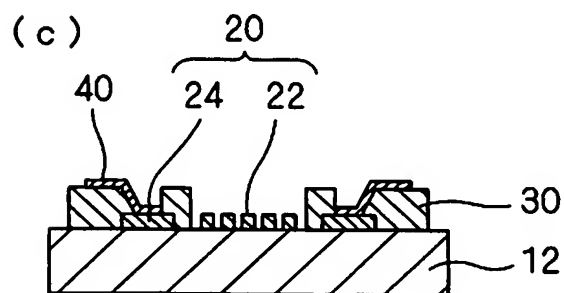
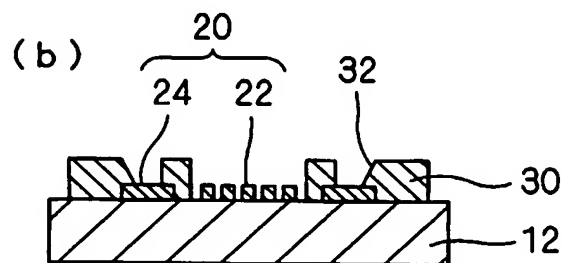
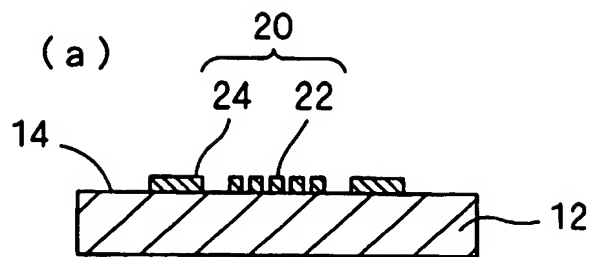
70 補強樹脂

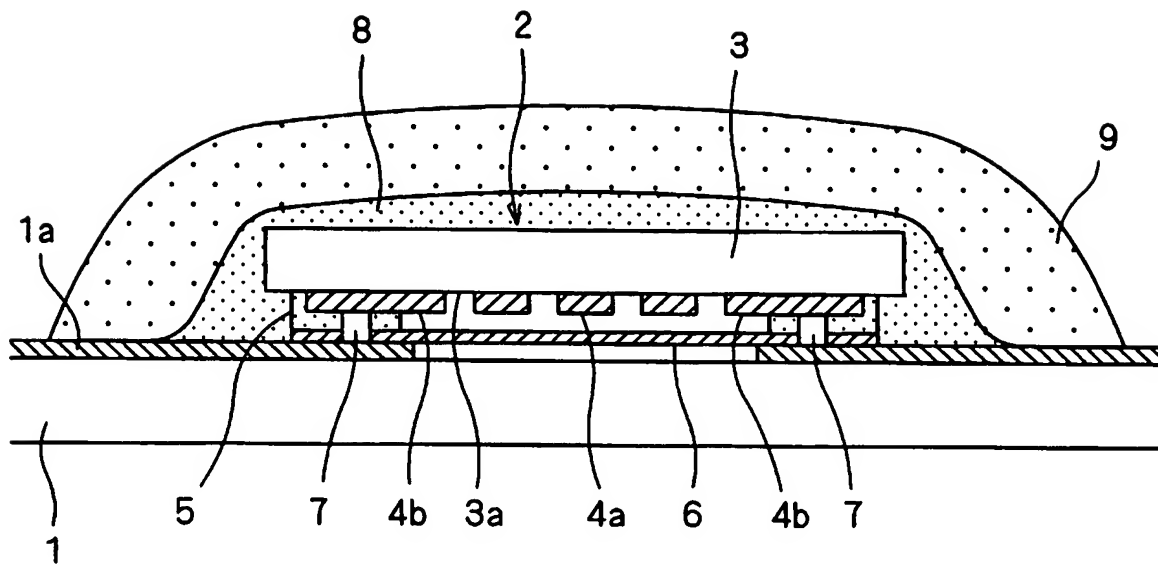
80 外部電極













【要約】

【課題】 小型化しつつ耐湿性を向上することができ、回路基板に実装した後に封止する必要がない弾性表面波装置及びその弾性表面波装置の製造方法を提供する。

【解決手段】 弾性表面波装置 10 は、圧電基板 12 と、圧電基板 12 の上面 14 に形成された、IDT 22 を含む導電パターン 20 と、圧電基板 12 の上面 14 において IDT 22 の周囲に配置された支持層 30 と、支持層 30 に配置された後、圧電基板 12 の主面の法線方向から見たとき圧電基板 12 の外周より内側が除去されて、圧電基板 12 の外周より内側に圧電基板 12 の外周と全周に渡って間隔を設けて延在するカバー 50 と、カバー 50 から圧電基板 12 の上面 14 の周部まで全体的に覆う補強樹脂 70 とを備える。

【選択図】 図 1

0 0 0 0 0 6 2 3 1

19900828

新規登録

京都府長岡京市天神二丁目2 6 番 1 0 号

株式会社村田製作所

0 0 0 0 0 6 2 3 1

20041012

住所変更

京都府長岡京市東神足1 丁目 1 0 番 1 号

株式会社村田製作所

# **Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)**

International application number: PCT/JP05/011169

International filing date: 17 June 2005 (17.06.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP  
Number: 2004-207896  
Filing date: 14 July 2004 (14.07.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 29 July 2005 (29.07.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse